



# 扬州中芯晶来半导体制造有限公司

YANGZHOU GENESIS-JINGLAI SEMICONDUCTOR MANUFACTURE Co.,LTD

## DK43N

硅 NPN 大功率开关晶体管

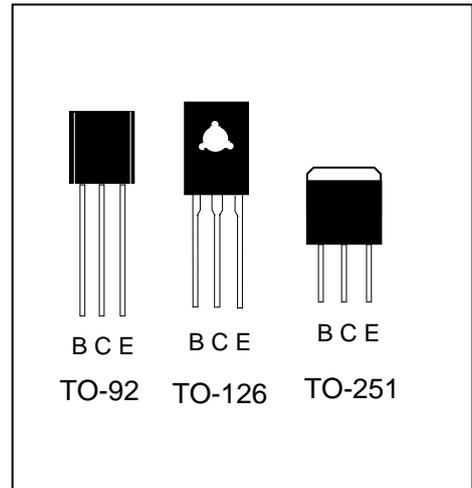
### ■用 途

主要用于供电电压为 110V~130V、非倍压整流的电子节能灯、日光灯电子镇流器及其它振荡电路等。

### ■极限参数

| 项 目                          | 符 号          | 极 限 值               | 单 位              |
|------------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 集电极-发射极电压                    | $V_{CEO}$    | 220                 | V                |
| 集电极-基极电压                     | $V_{CBO}$    | 350                 | V                |
| 发射极-基极电压                     | $V_{EBO}$    | 9                   | V                |
| 集电极电流                        | $I_C$        | 1.5                 | A                |
| 集电极功耗 $T_C=25^\circ\text{C}$ | $P_{tot(1)}$ | 15(TO-92)           | W                |
|                              |              | 40(TO-126、TO-251)   |                  |
| 集电极功耗 $T_a=25^\circ\text{C}$ | $P_{tot(2)}$ | 1.0(TO-92)          | W                |
|                              |              | 1.25(TO-126、TO-251) |                  |
| 结温                           | $T_{jm}$     | 150                 | $^\circ\text{C}$ |
| 贮存温度                         | $T_{stg}$    | -55~+150            | $^\circ\text{C}$ |

### ■外形结构



### ■电 特 性( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

| 项 目         | 符号            | 测试条件                                                    | 参数值        | 单位            |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 集电极-基极反向电流  | $I_{CBO}$     | $V_{CB}=350\text{ V}$                                   | $\leq 0.1$ | mA            |
| 发射极-基极反向电流  | $I_{EBO}$     | $V_{EB}=9\text{ V}$                                     | $\leq 1$   | mA            |
| 直流电流增益      | $h_{FE}$      | $V_{CE}=5\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$                   | 10~40      |               |
| 集电集-发射极饱和电压 | $V_{CE(sat)}$ | $I_C=1\text{ A}, I_B=0.25\text{ A}$                     | $\leq 1.0$ | V             |
| 基极-发射极饱和电压  | $V_{BE(sat)}$ | $I_C=1\text{ A}, I_B=0.25\text{ A}$                     | $\leq 1.2$ | V             |
| 集电极-发射极击穿电压 | $V_{(BR)CEO}$ | $I_C=1\text{ mA}$                                       | $\geq 220$ | V             |
| 贮存时间        | $t_S$         | $I_C=0.5\text{ A}, I_B=0.1\text{ A}, V_{CE}=5\text{ V}$ | $\leq 1.8$ | $\mu\text{s}$ |
| 特征频率        | $f_T$         | $V_{CE}=10\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}, f=1\text{ MHz}$  | $\geq 4$   | MHz           |